

提高电源开关的安全性、稳健性和可靠性

碳化硅 MOSFET

Nexperia碳化硅MOSFET的 R_{DSon} 温度稳定性高、开关速度快且短路耐用性佳，可满足日益增长的大功率和高电压工业应用需求，是电动汽车充电基础设施、光伏逆变器和电机驱动器的优选产品。



设计优势

- › 开关损耗非常低
- › 快速反向恢复
- › 开关速度快
- › 关断时的开关损耗不受温度变化影响
- › 固有体二极管速度很快且稳健性佳

主要技术特性

- › R_{DSon} 温度依赖性优于同类产品
- › 栅极电荷性能优越和栅极电荷比
 - 栅极驱动器功耗低
 - 对寄生导通的耐受性高
- › 阈值电压容差非常小
- › 体二极管稳健性强，正向电压非常低
- › 1200 V时漏电流更低

关键应用

- › 电动汽车充电基础设施
- › 光伏逆变器
- › 开关模式电源
- › 不间断电源
- › 电机驱动器



访问页面

- › 数据手册
- › 应用笔记
- › 新闻
- › 视频及更多信息

nexperia

EFFICIENCY WINS.

产品范围

型号	封装	V_{DS} 最大值(V)	R_{DSon} 典型值 ($m\Omega$) $T_j = 25^\circ C$	I_D 最大值(A) $TC = 25^\circ C$	T_j 最大值($^\circ C$)
NSF040120L3A0	 TO-247-3	1200	40	65	175
NSF080120L3A0			80	35	
NSF040120L4A0	 TO-247-4		40	65	
NSF080120L4A0			80	35	

SiC MOSFET | 命名



© 2023 Nexperia B.V.

保留所有权利。未经版权所有者事先书面同意，禁止复制本文全部或部分内容。本文档中所提供的信息不构成任何报价或合同的一部分，且被认为是准确可靠的，如有变更，恕不另行通知。对于使用本文档所产生的任何后果，出版方概不承担任何责任。出版内容既不传达也不暗示专利或者其他工业或知识产权下的任何许可。

nexperia.com

发布日期：
2023年10月

印刷：
荷兰

